

トランジスタ

2SD649

2SD649

シリコン NPN 三重拡散メサ形/Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

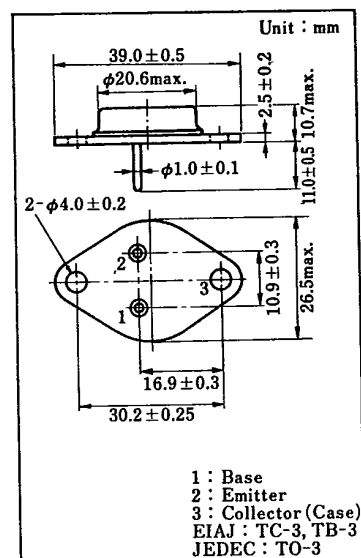
電源直結式水平偏向出力用/Line-Operated Horizontal
Deflection Output

■ 特 徴/Features

- コレクタ・エミッタ電圧 V_{CES} が高い。/High V_{CES}
- セン頭コレクタ電流 I_{CP} が大きい。/High I_{CP}

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	1500	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
セン頭コレクタ電流	I_{CP}	5	A
コレクタ電流	I_C	3	A
コレクタ損失($T_c \leq 90^\circ\text{C}$)	P_C	35	W
接合部温度	T_j	130	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-65 \sim +130$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=750\text{ V}, I_E=0$			100	μA
		$V_{CB}=1500\text{ V}, I_E=0$			1	mA
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=10\text{ mA}, I_C=0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=3\text{ A}$	4		12	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3\text{ A}, I_B=1\text{ A}$			7	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=3\text{ A}, I_B=1\text{ A}$			1.5	V
下降時間	t_f	$I_C=3\text{ A}, I_{Bend}=1\text{ A}, L_B=20\text{ }\mu\text{H}$			1	μs
蓄積時間	t_{stg}			13		μs

トランジスタ

T-33-11

2SD649

